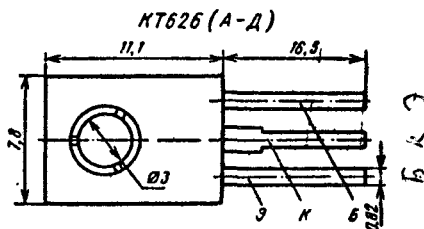


КТ626 (А, Б, В, Г, Д)

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р. Предназначены для применения в усилителях и генераторах коротковолнового диапазона и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при

$U_{кэ}=2$ В, $I_{к}=0,15$ А:

$T=+25^{\circ}\text{C}$:

КТ626А, КТ626Д	40...250
КТ626Б	30...100

КТ626В	15...45
КТ626Г	15...60
$T=+85^{\circ}\text{C}$:	
КТ626А, КТ626Д	40...500
КТ626Б	30...200
КТ626В	15...90
КТ626Г	15...120

$T=-40^{\circ}\text{C}$:

КТ626А, КТ626Д	20...250
КТ626Б	15...100
КТ626В	8...45
КТ626Г	8...60

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ}=10$ В, $I_{э}=30$ мА, не менее:

КТ626А, КТ626Б	75 МГц
КТ626В, КТ626Г, КТ626Д	45 МГц

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер КТ626А, КТ626Б при $I_{к}=0,5$ А, $I_{э}=0,05$ А и КТ626В, КТ626Г, КТ626Д при $I_{к}=0,5$ А, $I_{э}=0,1$ А, не более

1 В

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{кэ}=10$ В, $I_{э}=30$ мА, $f=5$ МГц

500 пс

Емкость коллекторного перехода при $U_{кэо}=10$ В

150* пФ

Обратный ток коллектора, не более:

КТ626А при $U_{кэо}=30$ В	10 мкА
$U_{кэо}=45$ В	1 мА

КТ626Б, КТ626В при $U_{кэо}=30$ В, КТ626Г, КТ626Д при $U_{кэо}=20$ В	150 мкА
--	---------

КТ626Б при $U_{кэо}=60$ В и КТ626В при $U_{кэо}=80$ В	1 мА
---	------

Обратный ток эмиттера при $U_{эо}=4$ В, не более:

КТ626А	10 мкА
КТ626Б, КТ626В, КТ626Г, КТ626Д	300 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база:

КТ626А	45 В
КТ626Б	60 В
КТ626В	80 В
КТ626Г, КТ626Д	20 В

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{эб}=100$ Ом:

КТ626А	45 В
КТ626Б	60 В
КТ626В	80 В
КТ626Г, КТ626Д	20 В

Постоянный ток коллектора

0,5 А

Импульсный ток коллектора

1,5 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при $T_{ж}\leq +60^{\circ}\text{C}$	6,5 Вт
при $T_{ж}=+85^{\circ}\text{C}$	4 Вт

Тепловое сопротивление переход — корпус

10 $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$

Температура р-п перехода

+125 $^{\circ}\text{C}$

Температура окружающей среды

-40 $^{\circ}\text{C}$.. $T_{ж}=+85^{\circ}\text{C}$

Изгиб выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм.

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора при температуре не выше +260 $^{\circ}\text{C}$ в течение не более 3 с.